

离子注入在核辐射探测器中的应用

@丁洪林 @唐祖梅 @张秀凤

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 <正> 半导体的离子注入,就是使杂质元素(如硼,磷,砷)的离子,在加速电压的作用下达达到5~100千电子伏的能量,对半导体衬底进行轰击,以得到所需要的杂质浓度的方法。离子束在半导体领域内的应用早已发现,而且一直在进行研究。1948年首先报道了用离子束使半导体电导类型转变的实验;1952年发表了用各种不同的气体离子轰击硅表面可

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(317KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者